Реєстраційна картка НДДКР

Державний реєстраційний номер: 0122U200830

Відкрита

Дата реєстрації: 16-09-2022

Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості

Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

КПКВК: 2201040

Напрям фінансування: 2.4 - розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1865.000

У тому числі по роках (тис. грн.):

Рік	Фінансування
2022	700.000
2023	1165.000

2. Замовник

Назва організації: Міністерство освіти і науки України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 38621185

Адреса: проспект Перемоги, буд. 10, м. Київ, 01135, Україна

Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України

Телефон: 380444813221

Телефон: +380444813221

Телефон: mon@mon.gov.ua

E-mail: mon@mon.gov.ua

WWW: https://mon.gov.ua/ua

3. Виконавець

Назва організації: Науково-виробниче підприємство "Електрон-Карат"-дочірнє підприємство ПрАТ "Концерн-Електрон"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 23273999

Підпорядкованість: Міністерство економіки України

Адреса: вул. Стрийська, буд. 202, м. Львів, Львівська обл., 79031, Україна

Телефон: 380322631065

E-mail: office@carat.electron.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Розроблення технології росту структур на основі антимоніду індію та виготовлення тестових зразків фотодіодів

Назва роботи (англ)

Development of technology for growth of structures based on indium antimonide and production of test samples of photodiodes

Мета роботи (укр)

Метою роботи є розроблення технології росту структур антимоніду індію (далі – InSb) з електронно-дірковим (n-p) переходом методом рідинно-фазної епітаксії (далі – РФЕ) для фотодіодів чутливих в спектральному діапазоні 3-5 мкм та виготовлення на їх основі тестових меза-фотодіодів для оптоелектронних систем спеціального призначення.

Мета роботи (англ)

The purpose of the work is to develop a technology for the growth of indium antimonide structures with an electron-hole (n-p) transition by the method of liquid-phase epitaxy for photodiodes sensitive in the spectral range of 3-5 μm and to manufacture test mesa-photodiodes based on them for special purpose optoelectronic systems.

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Нові речовини і матеріали

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка

Очікувані результати: Технології, Матеріали

Галузь застосування: опто- та мікроелектроніка

6. Етапи виконання

Номер	Початок	Закінчення	Звітний документ	Назва етапу
1	09.2022	12.2022	Проміжний звіт	Розроблення методик контролю параметрів шарів епітаксійної структури p-InSb/ n-InSb.
2	01.2023	06.2023	Проміжний звіт	Розроблення технологічної інструкції формування епітаксійної структури n-InSb/p-InSb.
3	07.2023	12.2023	Остаточний звіт	Виготовлення експериментальних зразків структур p-InSb/n-InSb та тестових зразків меза-фотодіодів.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 47.13.11

Індекс УДК: 621.38.049.77.002; 621.375.82.002, 621.315

8. Заключні відомості

Керівник організації:

Ваків Микола Михайлович (д. т. н., професор)

Керівники роботи:

Круковський Семен Іванович (д.т.н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Круковський С.І. (Тел.: +38 (096) 839-83-70)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.